

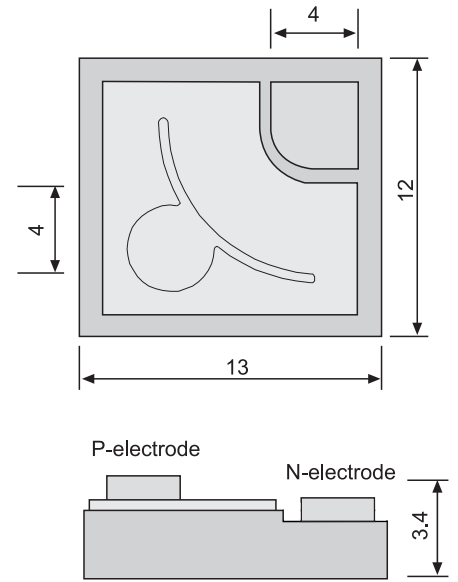


◆ 产品特点:

- 高亮度、长寿命
- 低电流驱动, 损耗小
- 户内外应用
- 芯片百分百测试分选
- 波长和光强良好的一致性

◆ 物理参数:

| | |
|------|---|
| P电极 | 金 |
| N电极 | 金 |
| 芯片尺寸 | 13mil x 12mil (330 ± 20μm x 305 ± 20μm) |
| 芯片厚度 | 3.4mil (85μm ± 10μm) |
| 焊盘尺寸 | 4.0mil (100 ± 10μm) in diameter |



单位: mil

◆ 光电参数: (T_C=22°C, I_F=20mA)

| 产品型号 | 波长范围 (λ _D , nm) | | 工作电压 (V _F , V) | 反向漏电流 (I _R , μA) @V _R =10V | 半波宽度 (Δλ, nm) | 最大电流 (I _F , mA) DC |
|-------------------|----------------------------|-------|---------------------------|--|---------------|-------------------------------|
| | Min | Max | | | | |
| S-13KBAUP*-450C** | 450 | 452.5 | < 3.4 | ≤ 2 | ≤ 30 | 30 |
| S-13KBAUP*-452C** | 452.5 | 455 | | | | |
| S-13KBAUP*-455C** | 455 | 457.5 | | | | |
| S-13KBAUP*-457C** | 457.5 | 460 | | | | |
| S-13KBAUP*-460C** | 460 | 462.5 | | | | |
| S-13KBAUP*-462C** | 462.5 | 465 | | | | |
| S-13KBAUP*-465C** | 465 | 467.5 | | | | |
| S-13KBAUP*-467C** | 467.5 | 470 | | | | |
| S-13KBAUP*-470C** | 470 | 472.5 | | | | |
| S-13KBAUP*-472C** | 472.5 | 475 | | | | |

◆ 光强等级: (T_C=22°C, I_F=20mA)

| 等级: | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | ... |
|----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| Po范围(mw) | 12.5~14.0 | 14~15.5 | 15.5~17.0 | 17.0~18.5 | 18.5~20.0 | 20.0~21.5 | 21.5~23.0 | 23.0~24.5 | ... |

◆ 其它说明

- 光电参数均系三安光电测试仪器在晶圆条件下测试, 98%符合标称值范围
- 芯片封装工艺最高温度低于280°C, 持续时间小于10秒
- GaN LED 芯片为静电敏感产品, 使用、运输时注意静电防护
- 主波长测量误差 ± 1.0nm
- 可根据客户要求订做特殊规格的芯片